

OIM-DC

		Basic	Middle
OIM-DC全般	OIM-DCの概説/構成	○	
	EBSDパターンの指数付について	○	△
	結晶方位の算出に関する計算法について	△	○
	結晶方位の算出について(3バンド法について)	○	△
	CI値の意味について	○	
	Fit値の意味について	○	
Phase Page について	Phase データのLoad について	○	
	Phase Parameters の見方	△	○
Hough Page について	Hough 変換の原理について	○	△
	Hough 変換のパラメーターについて	○	△
Index Page について	Solutions の見方	○	△
	HKLs の見方	△	○
	Ranking Factor について		○
	Pseudosymmetry について		○
	バンドの追加/削除につい	△	○
Interactive Page について	SEM像の取込/保存について	○	
	パターンの指数付け/保存(Record)について	○	
	Analysis 部分の見方について	△	○
Scan Page について	測定領域の設定について	○	
	Combo Scan について		○
	パターンの記録につて		○
	ChiScan について		○
Simulation Page について	Unit Cell/PF/IPF の表示について	○	○
キャリブレーションについて	キャリブレーションの考え方について	○	
	SEMのWDにキャリブレーション値を合わせる	○	
	Si 単結晶でキャリブレーションを行う		○
	一時的なキャリブレーションを行う		○
Setting Menu について	Preference の設定		○
	Superuser の設定	Environment Setting (座標系/試料傾斜角の設定)	○
その他の機能	SEM 像の Brightness/Contrast の調整		○
	取込むSEMの解像度の設定について		○
	SEM像の傾斜補正について		○
検出器の調整	Gain, Black, Exposure と照射電流の関係	○	
	Binning パラメータとConvolution Mask の関係		○
Background 処理について	Background処理の考え方	○	
	Standard モードによるBackground 処理	○	
	Enhanced モードによるBackground処理(1)	○	○
	Enhanced モードによるBackground処理(2)		○
SEM の条件設定	加速電圧の効果	○	△
	倍率と分解能の関係	○	△
	統計的データの意味		○
マテリアルデータの作成に関	同一結晶系/類似データの編集による作成		△
	ICDD等データベースを利用したデータの作成		△
	実際のパターンから結晶の対称性を推測		△
	実際のパターンでのマッチングによる確認		△